



CF-T19 Oxford PECVD 標準製程

○適用製程：

6吋、8吋晶圓

4吋、破片需使用載盤，禁止貼任何種類的貼帶

石英、玻璃基材尺寸、面積均需小於6吋、高度小於3mm

○製程委託條件

Thickness：30nm~1000nm

Uniformity：< 5%

○製程參數

Process Chamber 1：SiH₄-SiO_x

Recipe	SiH ₄ (sccm)	N ₂ O(sccm)	N ₂ (sccm)	RF(W)	Temp(°C)	P(mTorr)
STD SiO _x	8.5	710	161.5	20	300	1000

Process Chamber 1：SiH₄-SiN_x

Recipe	SiH ₄ (sccm)	NH ₃ (sccm)	N ₂ (sccm)	RF(W)	Temp(°C)	P(mTorr)
STD SiN _x	25	30	980	20	300	1000

○其他

如果需要其他製程條件，請與機台工程師討論